

Спосіб виготовлення омичного контакту метал-напівпровідника до перовськиту CsPbBr_3 включає механічне та хімічне полірування підкладинок CsPbBr_3 та нанесення металу. При цьому поверхню підкладинки перед нанесенням металу обробляють не менше 20 хвилин в аргонівій плазмі при напрузі не менше 500 В та при температурі не менше 100 °С.